

Содержание

• Неэлектронные свойства полупроводников (атомная структура, диффузия)

Гурбанов Г.Р., Адыгезалова М.Б.

Характер взаимодействия в системе SnSb_2Te_4 – SnBi_2Te_4 и термоэлектрические свойства твердых растворов $(\text{SnSb}_2\text{Te}_4)_{1-x}(\text{SnBi}_2\text{Te}_4)_x$ 483

• Электронные свойства полупроводников

Бахадириханов М.К., Исамов С.Б., Зикриллаев Н.Ф., Турсунов М.О.

Аномальные фотоэлектрические явления в кремнии с нанокластерами атомов марганца 489

Рабданов М.Р., Степуренко А.А., Гумметов А.Э., Исмаилов А.М.

Температурная зависимость проводимости нитевидных кристаллов теллура 493

Nemov S., Kostyuk O., Dzundza B., Chernyak L., Dashevsky Z.

High Perfection Bulk and Film Thermoelectrics Based on PbTe Doped by In 499

Abraham R.J.S., Shuman V.B., Portsel L.M., Lodygin A.N., Astrov Yu.A., Abrosimov N.V., Pavlov S.G., Hübers H.-W., Simmons S., Thewalt M.L.W.

Thermal Activation of Valley-Orbit States of Neutral Magnesium in Silicon 500

• Поверхность, границы раздела, тонкие пленки

Abdel Moez A., Salem M.A., Elmeleegi A., Elmandouh Z.S.

Investigation of Structure, First Order Optical Susceptibility, Non-linear Optical, Electrical Susceptibility Results and IV Characterizations of Graphene Multilayer 501

• Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

Семакова А.А., Баженов Н.Л., Мынбаев К.Д., Черняев А.В., Кижяев С.С., Стоянов Н.Д.

Исследование вольт-амперных характеристик светодиодных гетероструктур на основе InAsSb в диапазоне температур 4.2–300 К 502

• Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники

Fan Zhang, Черкова С.Г., Володин В.А.

Формирование нанокристаллов германия в пленках $\text{GeO}[\text{SiO}_2]$ и $\text{GeO}[\text{SiO}]$ 507

Нагалиук С.С., Мохов Е.Н., Казарова О.П., Бер Б.Я., Анисимов А.А., Брөөв И.Д.

Возникновение зеленой окраски в кристаллах AlN, выращенных на затравках SiC 513

• Углеродные системы

Морозов М.Ю., Моисеенко И.М., Коротченков А.В., Попов В.В.

Замедление терагерцовых плазменных волн в конической структуре с графеном, накачиваемым с помощью оптических плазменных волн 518

• Физика полупроводниковых приборов

Тандоев А.Г., Мнацаканов Т.Т., Юрков С.Н.

Вольт-амперная характеристика мощных диодных структур с резкой асимметрией инжектирующей способности эмиттеров 524

• Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур

Brella M., Taabouche A., Gharbi B., Gheriani R., Bouachiba Y., Bouabellou A., Serrar H., Touil S., Laggoune K., Boudlissa M.

Comparison of Thin Films of Titanium Dioxide Deposited by Sputtering and Sol–Gel Methods for Waveguiding Applications 533

Pradhan D., Kar J.P.

Microstructural and Electronic Properties of Rapid Thermally Grown MoS_2 /Silicon Hetero-Junctions with Various Process Parameters 534